

(19)



JAPANESE PATENT OFFICE

PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11) Publication number: 2000357842 A

(43) Date of publication of application: 26.12.00

(51) Int. Cl

H01S 5/20
// H01L 33/00

(21) Application number: 11169504

(71) Applicant: **SONY CORP**

(22) Date of filing: 16.06.99

(72) Inventor:
TOJO TAKESHI
OZAWA MASABUMI
UCHIDA SHIRO
HIRATA SHOJI

(54) SEMICONDUCTOR LASER

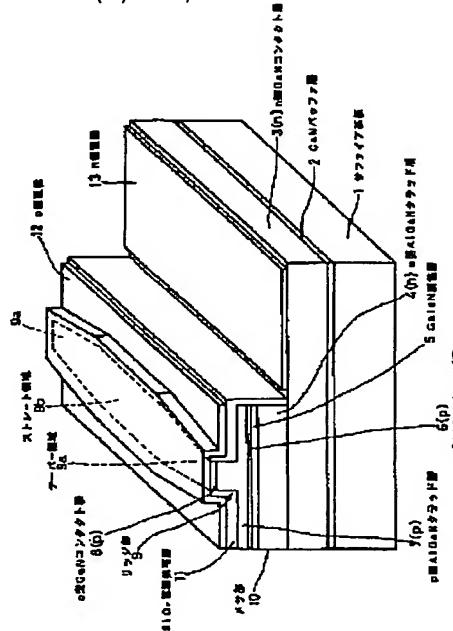
(57) Abstract:

PROBLEM TO BE SOLVED: To provide a semiconductor laser using nitride based III-V compound semiconductor which can easily realize decrease of a driving voltage, stabilization in transverse mode, increase of a divergence angle of beams in the horizontal direction of a far field pattern, prevention of deterioration of laser characteristic which is to be caused by irregularity of the form of a resonator end surface, and improvement of noise characteristic.

SOLUTION: In a GaN based semiconductor laser of a refractive index waveguide type in which SiO₂ current constriction layers 11 absorbing no lights from a GaInN active layer 5 are formed on both sides of a ridge part 9 composed of an upper layer of a P-type AlGaN clad layer 7 and a P-type GaN contact layer 8, tapered regions 9a whose width decreases from the central part of the resonator lengthwise direction toward both ends of the resonator lengthwise direction are formed in both end parts of the ridge 9 in the resonator lengthwise direction. The central part of the ridge 9 in the resonator lengthwise direction is made a straight region 9b halving a constant width. The width W1 of both ends of the ridge 9 in the resonator lengthwise direction is

made at most 3 μ m. The width W2 of the central part of the ridge 9 in the resonator lengthwise direction is made at least 4 μ m.

COPYRIGHT: (C)2000,JPO



(19)日本国特許庁 (JP)

(12) 公開特許公報 (A)

(11)特許出願公開番号

特開2000-357842

(P2000-357842A)

(43)公開日 平成12年12月26日 (2000.12.26)

(51)Int.Cl.
H 01 S 5/20
// H 01 L 33/00

識別記号

F I
H 01 S 3/18
H 01 L 33/00

テマコト (参考)
6 6 0 5 F 0 4 1
C 5 F 0 7 3

審査請求 未請求 請求項の数4 OL (全10頁)

(21)出願番号 特願平11-169504

(22)出願日 平成11年6月16日 (1999.6.16)

(71)出願人 000002185
ソニー株式会社
東京都品川区北品川6丁目7番35号
(72)発明者 東條 剛
東京都品川区北品川6丁目7番35号 ソニー
一株式会社内
(72)発明者 小沢 正文
東京都品川区北品川6丁目7番35号 ソニー
一株式会社内
(74)代理人 100082762
弁理士 杉浦 正知

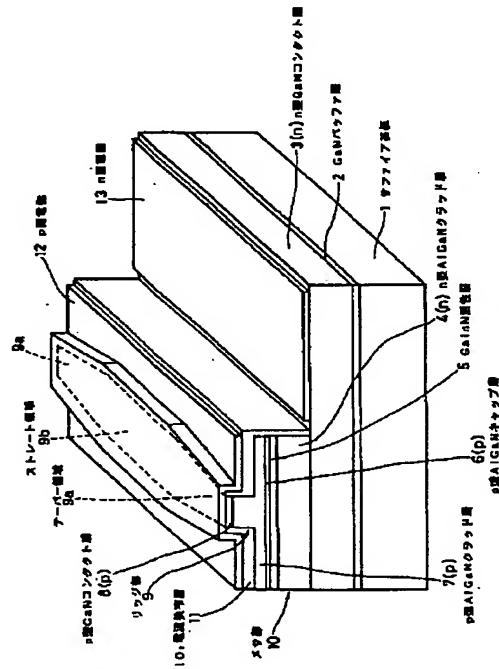
最終頁に続く

(54)【発明の名称】 半導体レーザ

(57)【要約】

【課題】 駆動電圧の低減、横モードの安定化、遠視野像の水平方向のビーム拡がり角の拡大、共振器端面の形状のバラツキによるレーザ特性の悪化防止およびノイズ特性の向上を容易に実現することのできる窒化物系I-V族化合物半導体を用いた半導体レーザを提供する。

【解決手段】 p型AlGaNクラッド層7の上層部、p型GaNコンタクト層8からなるリッジ部9の両側に、GaInN活性層5からの光を吸収しないSiO₂電流狭窄層1が設けられた屈折率導波型のGaN系半導体レーザにおいて、リッジ部9の共振器長方向の両端部に、共振器長方向の中央部から共振器長方向の両端部に向かう方向に幅が減少するテーパー領域9aを設ける。リッジ部9の共振器長方向の中央部は幅が一定のストレート領域9bとする。リッジ部9の共振器長方向の両端面における幅W₁を3μm以下、リッジ部9の共振器長方向の中央部における幅W₂を4μm以上に設定する。



【特許請求の範囲】

【請求項1】 第1導電型の第1のクラッド層と、上記第1のクラッド層上の活性層と、上記活性層上の第2導電型の第2のクラッド層とを有し、上記第2のクラッド層に設けられたリッジ部の両側の部分に、上記活性層からの光を吸収しない材料からなる電流狭窄層が設けられた電流狭窄構造を有する窒化物系III-V族化合物半導体を用いた半導体レーザにおいて、上記リッジ部は、共振器長方向の両端部に上記共振器長方向の中央部から上記共振器長方向の両端部に向かう方向に幅が減少するテーパー領域を有することを特徴とする半導体レーザ。

【請求項2】 上記リッジ部の上記共振器長方向の中央部における幅が4μm以上であり、上記リッジ部の上記共振器長方向の両端面における幅が3μm以下であることを特徴とする請求項1記載の半導体レーザ。

【請求項3】 上記リッジ部の上記共振器長方向の中央部における幅が4μm以上であり、上記リッジ部の上記共振器長方向の両端面における幅が2μm以上3μm以下であることを特徴とする請求項1記載の半導体レーザ。

【請求項4】 上記リッジ部の上記共振器長方向の中央部における幅が4μm以上であり、上記リッジ部の上記共振器長方向の両端面における幅が2μm以下であることを特徴とする請求項1記載の半導体レーザ。

【発明の詳細な説明】

【0001】

【発明の属する技術分野】 この発明は半導体レーザに関するものであり、特に、窒化物系III-V族化合物半導体を用いた半導体レーザに関するものである。

【0002】

【従来の技術】 GaNに代表される窒化物系III-V族化合物半導体（以下「GaN系半導体」ともいう）は、他のIII-V族化合物半導体と比較してエネルギーバンドギャップを大きくすることができるため、青色乃至紫外領域の短波長帯で発振可能な半導体レーザの材料として有望である。特に、このGaN系半導体を用いた半導体レーザは、既存の光学系を使用して読み出し/書き込みの行われる光ディスクの限界波長とされている400nm前後の発振波長が得られることから、高記録密度の光ディスク装置の光源として大いに注目されている。

【0003】 図4および図5は、これまでに実現されている従来のGaN系半導体レーザの一例を示す（例えばJapanese Journal of Physics Letters vol.36 p.L1568）。ここで、図4は斜視図、図5は平面図である。ここに示す従来のGaN系半導体レーザは、屈折率導波型のものである。

【0004】 図4および図5に示すように、この従来のGaN系半導体レーザにおいては、c面のサファイア（Al₂O₃）基板101上にアンドープのGaNバッファ層102を介して、n型GaNコンタクト層103、n型AlGaNクラッド層104、GaN活性層105、p型AlGaNキャップ層106、p型AlGaNクラッド層107およびp型GaNコンタクト層108が順次積層されている。

【0005】 p型AlGaNクラッド層107の上層部およびp型GaNコンタクト層108は、一方に延在するストレートストライプ型のリッジ形状を有する。符号109は、これらのp型AlGaNクラッド層107の上層部およびp型GaNコンタクト層108により構成されるリッジ部を示す。このリッジ部109は共振器長方向に均一な幅Wを有する。なお、このリッジ部109の幅（リッジ幅ともいう）Wは、リッジ部109の底部での幅を指す。

【0006】 n型AlGaNクラッド層104、GaN活性層105、p型AlGaNキャップ層106およびp型AlGaNクラッド層107の下層部は、一方に延在する所定のメサ形状を有する。符号110は、そのメサ部を示す。なお、図5においては、このメサ部110に対応する部分が示され、これに隣接する部分は図示省略されている。

【0007】 リッジ部109の両側の部分には、GaN活性層105からの光を吸収しないSiO₂電流狭窄層111が成膜され、これによって電流狭窄構造が形成されている。このSiO₂電流狭窄層111は、電極間での短絡を防止するためにメサ部110の側面にも設けられている。また、このようにリッジ部109の両側にSiO₂電流狭窄層111が成膜されることによって、リッジ部109に対応する部分の屈折率が高く、その両側の部分の屈折率が低いステップ状の屈折率分布が接合と平行な方向に作り付けられている。

【0008】 p型GaNコンタクト層108およびSiO₂電流狭窄層111上には、Ni/Pt/Au電極のようなp側電極112が設けられ、メサ部110に隣接するn型GaNコンタクト層103上には、Ti/Al電極のようなn側電極113が設けられている。

【0009】 また、この従来のGaN系半導体レーザの両共振器端面は、サファイア基板101をその上のレーザ構造を形成するGaN系半導体層と共に劈開（疑似劈開）することにより形成された疑似劈開面により構成されている。ここで、サファイア基板を用いたGaN系半導体レーザでは、レーザ構造を形成するGaN系半導体層を反応性イオンエッチング（RIE）法によりエッチングし、このエッチングにより形成された切断面（エッチト・ファセット）を共振器端面とすることも可能である。しかしながら、この場合、サファイア基板をRIE法によりエッチングすることが困難であるため、共振器

端面から出射されるレーザ光の一部がサファイア基板の表面で反射し、遠視野像（FFP）に乱れが生じる。そのようなGaN系半導体レーザを光ディスク装置の光源として用いた場合、光学ピックアップとしての性能は低下する。これに対して、疑似劈開面により共振器端面が構成されたこの従来のGaN系半導体レーザでは、共振器端面から出射されたレーザ光がサファイア基板表面で反射されることが無く、レーザ光の遠視野像の形状が良好である。

【0010】上述のように構成された従来のGaN系半導体レーザでは、リッジ内外の実効屈折率差 Δn 、すなわち、リッジ部109に対応する部分とその両側の部分との実効屈折率差 Δn により、接合と平行な方向（水平方向）の光場がリッジ部109に対応する部分に閉じ込められる、いわゆる屈折率導波（実屈折率導波）が実現されている。これにより、この従来のGaN系半導体レーザでは、低閾値電流かつ比較的安定した水平横モードでの発振が得られている。

【0011】

【発明が解決しようとする課題】しかしながら、上述した従来のGaN系半導体レーザ、すなわち、ストレートストライプ型のリッジ構造を有するGaN系半導体レーザにおいては、次のような問題があった。

【0012】すなわち、図4および図5に示す従来のGaN系半導体レーザにおいて、共振器端面から出射されるレーザ光の横モードは、共振器端面でのリッジ幅の影響を強く受けることから、横モードを安定に維持するためには、リッジ幅Wを3μm以下程度とすることが望ましい。しかしながら、この従来のGaN系半導体レーザでは、リッジ幅Wを狭くした場合、p型GaNコンタクト層108とp側電極112とのコンタクト面積が減少することにより、電流経路が狭くなり微分抵抗が高まるため、駆動電圧が上昇する。また、この場合、GaN活性層105における利得領域の幅が減少し、導波ロスが増加することにより、駆動電流の上昇をも引き起こしかねない。

【0013】このように、従来のGaN系半導体レーザにおいては、駆動電圧の上昇を抑える観点からリッジ幅Wを3μmよりあまり狭くすることはできず、そのため、高次の水平横モードが発生しやすいという問題があった。水平横モードに高次のモードが発生すると、電流-光出力特性に非線形性（キンク）が現れると共に、レーザ光の出射角、出射方向が変化し、レーザ特性は悪化する。特に、電流-光出力特性の非線形性が使用光出力よりも低いところで発生した場合、ジッタが極端に悪化するため、そのような半導体レーザを光ディスク装置の光源として使用することはできなくなる。

【0014】また、GaN系半導体レーザを光ディスク装置の光源として用いる場合、遠視野像の水平方向のビーム拡がり角 $\theta//$ が同程度であれば、従来使用されてい

るAlGaAs系半導体レーザやAlGaN系半導体レーザなどと比較して、組み立て時に厳しい位置精度が要求される。そのため、GaN系半導体レーザを光ディスク装置の光源に用いる場合、出射端面でのビーム径の縮小化を図り、遠視野像の水平方向のビーム拡がり角 $\theta//$ を、例えば8°程度以上に拡大してやる必要がある。この理由からも、リッジ幅Wが3μmでは不十分である。

【0015】さらに、この従来のGaN系半導体レーザにおいては、次のような理由から、リッジ幅Wはさらに狭く設定されることが望ましい。

【0016】すなわち、図4および図5に示す従来のGaN系半導体レーザでは、その動作時に注入キャリアによるプラズマ効果によってリッジ部109に対応する部分の屈折率が低下し、リッジ内外の屈折率分布に変化が生じ、極端な場合、水平横モードに高次のモードが発生することがある。これを防止し、水平横モードをより安定なものとするためには、リッジ内外の実効屈折率差 Δn を、プラズマ効果による屈折率の低下分（ 2×10^{-3} 程度）より大きくする必要がある。

【0017】ここで、図6に、図4および図5に示すと同様のストレートストライプ型のリッジ構造を有するGaN系半導体レーザにおける基本モードの発振条件を示す。図6において、横軸はリッジ内外の実効屈折率差 Δn を示し、縦軸はリッジ幅Wを示す。また、曲線Aは、GaNの屈折率 $n = 2.504$ 、波長 $\lambda = 400\text{nm}$ の条件を与えて求めた1次モードのカットオフ条件であり、破線Bは、キャリアのプラズマ効果による屈折率の低下分を考慮したときの実効屈折率差 Δn の下限（ $\Delta n = 2 \times 10^{-3}$ ）を示す。このGaN系半導体レーザを基本モードで発振させるためには、通常、図6において、リッジ内外の実効屈折率差 Δn およびリッジ幅Wを曲線Aの下側の領域に設定すればよいが、キャリアのプラズマ効果を考慮したときの基本モードの発振条件は、曲線A、破線Bおよび横軸で囲まれた領域（図6中、斜線を施した部分）となり、この場合、リッジ幅Wは2μm以下に設定する必要がある。

【0018】また、サファイア基板上に作製されるGaN系半導体レーザでは、サファイア基板自体に劈開性がないために、GaN基板のような劈開の容易な基板上に作製される他の種類の半導体レーザ、具体的には、GaN基板を用いたAlGaAs系半導体レーザやAlGaN系半導体レーザのように、機械的な加工による共振器端面の形成が容易ではない。そのため、図4および図5に示す従来のGaN系半導体レーザにおいては、相対する2つの共振器端面が、リッジ部109の延長方向したがって共振器長方向に対して垂直にならないことがある。このように共振器端面が共振器長方向に対して傾斜すると、その共振器端面から出射されるレーザ光の光軸も傾く。このことは、図7に示す共振器端面の

水平方向の傾きとレーザ光の出射方向との関係より明らかである。

【0019】共振器端面の傾きは、上述のようにレーザ光の出射方向を変化させるのみならず、端面反射率の減少、スロープ効率の増大または減少、閾値電流の増大などを招き、レーザ特性に深刻な影響を与える。そこで、本発明者は、図4および図5に示すと同様のストレートストライプ型のリッジ構造を有するGaN系半導体レーザにおいて、共振器端面が水平方向に傾いた場合、端面反射率および閾値電流がどの程度変化するかを調べた。図8および図9にその結果を示す。図8は、共振器端面の水平方向傾きと端面反射率との関係を示し、図9は、共振器端面の水平方向の傾きと閾値電流の上昇分との関係を示す。図8および図9において、曲線Aはリッジ幅W=4μmとした場合、曲線Bはリッジ幅W=3μmとした場合、曲線Cはリッジ幅W=2μmとした場合の結果を示す。図8および図9より、共振器端面の傾きが大きくなるに従って端面反射率が低下し、閾値電流が上昇することがわかる。

【0020】こうした現象は、ウェーハ上の互いに隣り合う領域に形成されるチップ間で異なるため、同一ロット内での半導体レーザの特性のバラツキが大きくなり、製造歩留まりを低下させる要因になる。

【0021】ここで、図8および図9からは、リッジ幅Wが4μm→3μm→2μmと次第に小さくなるに従って、共振器端面の傾きに伴う端面反射率の低下および閾値電流の上昇の度合いが低減されることがわかる。したがって、従来のリッジ構造を有するGaN系半導体レーザでは、リッジ幅Wを狭くするほど、共振器端面の形状（主にその傾き）のバラツキによるレーザ特性の悪化が防止され、製造歩留まりが向上する。

【0022】また、従来のGaN系半導体レーザでは、共振器端面におけるリッジ幅Wが広くなるほど、戻り光による搅乱の影響を受けやすくなるため、ノイズ特性を向上の観点からもリッジ幅Wは狭くすることが好ましい。

【0023】しかしながら、すでに述べたように、従来のGaN系半導体レーザにおいては、駆動電圧の上昇を抑制する観点からリッジ幅Wの下限は3μm程度に制限される。そのため、従来のGaN系半導体レーザでは、駆動電圧を上昇させることなく、共振器端面形成の良否がレーザ特性に及ぼす悪影響の低減を図り、かつ、ノイズ特性を向上させることができた。

【0024】したがって、この発明の目的は、駆動電圧の低減、横モードの安定化、遠視野像の水平方向のビーム拡がり角の拡大、共振器端面の形状のバラツキによるレーザ特性の悪化防止およびノイズ特性の向上を容易に実現することのできる窒化物系III-V族化合物半導体を用いた半導体レーザを提供することにある。

【0025】

【課題を解決するための手段】上記目的を達成するため、この発明は、第1導電型の第1のクラッド層と、第1のクラッド層上の活性層と、活性層上の第2導電型の第2のクラッド層とを有し、第2のクラッド層に設けられたリッジ部の両側の部分に、活性層からの光を吸収しない材料からなる電流狭窄層が設けられた電流狭窄構造を有する窒化物系III-V族化合物半導体を用いた半導体レーザにおいて、リッジ部は、共振器長方向の両端部に共振器長方向の中央部から共振器長方向の両端部に向かう方向に幅が減少するテーパー領域を有することを特徴とするものである。

【0026】この発明において、窒化物系III-V族化合物半導体はGaN、Al、In、BおよびTlからなる群より選ばれた少なくとも1種類のIII族元素と、少なくともNを含み、場合によってはさらにAsまたはPを含むV族元素とからなる。

【0027】この発明において、電流狭窄層の材料としては、例えば、酸化シリコン(SiO₂)、窒化シリコン(SiN)などの誘電体、AlGaN、GaN、GaNなどの窒化物系III-V族化合物半導体、ZnSなどのII-VI族化合物半導体が用いられる。

【0028】この発明においては、駆動電圧の上昇を抑制しつつ、横モードを安定に維持するために、好適には、リッジ部の共振器長方向の中央部における幅が4μm以上に選ばれ、かつ、リッジ部の共振器長方向の両端面における幅が3μm以下に選ばれる。特に、出射されるレーザ光の横モードは、リッジ部の共振器長方向の両端部における幅（共振器端面での幅）の影響を強く受けたため、リッジ部の共振器長方向の両端面における幅については、より好適には2μm以上3μm以下に選ばれ、さらに好適には2μm以下に選ばれる。

【0029】上述のように構成されたこの発明によれば、リッジ部が共振器長方向の両端部に共振器長方向の中央部から共振器長方向の両端部に向かう方向に幅が減少するテーパー領域を有することにより、リッジ部の共振器長方向の両端面における幅よりも、リッジ部の共振器長方向の中央部における幅の方が広くなる。そのため、横モードを安定に維持するために、リッジ部の共振器長方向の両端面における幅を狭く設定した場合であっても、それとは独立に、リッジ部の共振器長方向の中央部における幅を広く設定することができる。これにより、電極とのコンタクト面積を広くし、リッジ部での抵抗成分を低減することができるので、半導体レーザの駆動電圧を低減することができる。特に、この発明においては、リッジ部の共振器長方向の中央部における幅を4μm以上に設定し、かつ、リッジ部の共振器長方向の両端面における幅を3μm以下に設定した場合、駆動電圧を上昇させることなく、横モードの安定化を図ることができる。横モードの安定化については、リッジ部の共振器長方向の両端面における幅を2μm以下に設定し

た場合、高次の水平横モードの発生を抑制することができる、より効果的である。

【0030】また、この発明によれば、リッジ部の共振器長方向の両端部のテーパー領域での波面整形効果により、遠視野像の水平方向のビーム拡がり角を広くすることができる上に、リッジ部の共振器長方向の両端面における幅を狭くすることによって、遠視野像の水平方向のビーム拡がり角をさらに広くすることができる、この半導体レーザを光ディスク装置の光源に用いる場合、組み立て時に要求される厳しい位置精度を緩和することができる。また、この際、リッジ部の共振器長方向の中央部における幅を、リッジ部の共振器長方向の両端面における幅とは独立に広く設定することにより、電極コンタクト面積を減少させずに遠視野像の水平方向のビーム拡がり角の拡大を図ることができるので、信頼性良く遠視野像を整形することが可能である。

【0031】また、この発明によれば、リッジ部の共振器長方向の両端面における幅を狭くした場合、共振器端面の形状による端面反射率の低下、閾値電流の上昇、スロープ効率の変化を抑制することができる。これにより、共振器端面の形状のバラツキによるレーザ特性の悪化を防止することができるので、特性の良好な半導体レーザを高い製造歩留まりで得ることができる。また、リッジ部の共振器長方向の両端面における幅を狭くした場合、半導体レーザが戻り光によって搅乱される程度が抑制されるので、戻り光によって誘起されるノイズを低減することができる。この際、この発明では、リッジ部の共振器長方向の中央部における幅を、リッジ部の共振器長方向の両端面における幅とは独立に広く設定することができるので、リッジ部の共振器長方向の両端面における幅を狭くすることにより得られる利点を、駆動電圧を上昇させることなく得ることができる。

【0032】

【発明の実施の形態】以下、この発明の実施形態について図面を参照しながら説明する。なお、実施形態の全図において、同一または対応する部分には同一の符号を付す。

【0033】まず、この発明の第1の実施形態について説明する。図1および図2は、この発明の第1の実施形態によるGaN系半導体レーザを示す。ここで、図1は斜視図、図2は平面図である。このGaN系半導体レーザは、屈折率導波型のものである。

【0034】図1および図2に示すように、この第1の実施形態によるGaN系半導体レーザにおいては、例えば、c面のサファイア基板1上にアンドープのGaNバッファ層2を介して、n型GaNコンタクト層3、n型AlGaNクラッド層4、GaN活性層5、p型AlGaNキャップ層6、p型AlGaNクラッド層7およびp型GaNコンタクト層8が順次積層されている。n型AlGaNクラッド層4およびp型AlGaNクラ

ッド層7のAl組成は例えば6～8%程度であり、GaN活性層5のIn組成は例えば15%程度である。このGaN系半導体レーザの発光波長は400nm程度である。また、p型AlGaNキャップ層6のAl組成は20%程度である。

【0035】p型AlGaNクラッド層7の上層部およびp型GaNコンタクト層8は、一方向に延在するテープーストライプ型のリッジ形状を有する。符号9は、これらのp型AlGaNクラッド層7の上層部およびp型GaNコンタクト層8により構成されたリッジ部を示す。このリッジ部9の構成については、後に詳細に説明する。

【0036】n型AlGaNクラッド層4、GaN活性層5、p型AlGaNキャップ層6およびp型AlGaNクラッド層7の下層部は、一方向に延在する所定のメサ形状を有する。符号10はそのメサ部を示す。なお、図2においては、このメサ部10に対応する部分が示され、これに隣接する部分は図示省略されている。

【0037】リッジ部9の両側の部分には、例えば、GaN活性層5からの光を吸収しないSiO₂電流狭窄層11が成膜され、これによって電流狭窄構造が形成されている。このSiO₂電流狭窄層11は、電極間での短絡を防止するためにメサ部10の側面にも設けられている。また、このようにリッジ部9の両側にSiO₂電流狭窄層11が成膜されることによって、リッジ部9に対応する部分の屈折率が高く、その両側の部分の屈折率が低いステップ状の屈折率分布が接合と平行な方向に作り付けられている。なお、ここでリッジ内外の実効屈折率差 Δn は、キャリアのプラズマ効果によってリッジ部9に対応する部分の屈折率が低下することを考慮して、好適には例えば 2×10^{-3} 以上に選ばれる。この例の場合、リッジ内外の実効屈折率差 Δn は例えば 2×10^{-3} に設定される。

【0038】p型GaNコンタクト層8およびSiO₂電流狭窄層11の上には、例えばN_i/P_t/Au電極のようなp側電極12が設けられ、メサ部10に隣接するn型GaNコンタクト層3上には、例えばTi/AI電極のようなn側電極13が設けられている。

【0039】また、このGaN系半導体レーザの両共振器端面は、サファイア基板1をその上のレーザ構造を形成するGaN系半導体層と共に劈開（疑似劈開）することにより形成された疑似劈開面からなる。この場合、共振器端面から出射されるレーザ光が、サファイア基板1の表面で反射されることがなく、したがって、このレーザ光の遠視野像の形状は良好である。

【0040】上述のように構成されたこの第1の実施形態によるGaN系半導体レーザでは、リッジ内外の実効屈折率差 Δn 、すなわち、リッジ部9に対応する部分と、その両側の部分との実効屈折率差 Δn により、水平方向の光場がリッジ部9に対応する部分に閉じ込められる。

いわゆる屈折率導波（実屈折率導波）が実現されている。これにより、このGaN系半導体レーザでは、低閾値電流かつ比較的安定した水平横モードでの発振が得られている。さらに、このGaN系半導体レーザでは、リッジ部9の共振器長方向の両端面における幅が好適には3μm以下、より好適には2μm以下に設定されることにより、より一層の横モードの安定化を図ることが可能である。

【0041】以下に、この第1の実施形態によるGaN系半導体レーザにおけるリッジ部9の構成について詳細に説明する。

【0042】すなわち、図1および図2に示すように、このGaN系半導体レーザにおけるリッジ部9は、共振器長方向の両端部のそれぞれの領域に、共振器長方向の中央部から共振器長方向の両端部に向かう方向に、連続的に幅が減少するようにテーパーが施されたテーパー領域9aを有する。また、このリッジ部9は、共振器長方向の中央部の領域に幅が均一なストレート領域9bを有する。

【0043】このリッジ部9において、共振器長方向の両端部に設けられた2つのテーパー領域9aは互いにほぼ等しい長さL₁を有する。これらのテーパー領域9aの合計の長さ2L₁は、十分な波面整形効果が得られるように、例えば、共振器長L（L=2L₁+L₂、L₂はストレート領域9bの長さ）の10分の1以上、すなわち、2L₁≥L/10となるように選ばれる。

【0044】また、図2において、W₁はリッジ部9の共振器長方向の両端面における幅を示し、W₂はリッジ部9の共振器長方向の中央部における幅を示す。ここで、幅W₁は、共振器長方向の両端面におけるリッジ部9の底部での幅を指し、幅W₂は、共振器長方向の中央部におけるリッジ部9の底部での幅を指す。これらのリッジ部9の共振器長方向の両端面における幅W₁およびリッジ部9の共振器長方向の中央部における幅W₂は、W₁ < W₂の関係を満たしている。さらに、これらのリッジ部9の共振器長方向の両端面における幅W₁およびリッジ部9の共振器長方向の中央部における幅W₂は、駆動電圧の上昇を抑制しつつ、横モードを安定に維持するために、好適には、W₁≤3μmかつW₂≥4μmとなるように選ばれ、より好適には、2μm≤W₁≤3μmかつW₂≥4μmとなるように選ばれ、さらに好適には、W₁≤2μmかつW₂≥4μmとなるように選ばれる。

【0045】ここで、この第1の実施形態によるGaN系半導体レーザの各部の寸法の一例を挙げると、共振器長L=500μm、リッジ部9のテーパー領域9aの長さL₁=100μm、ストレート領域9bの長さL₂=300μm、リッジ部9の共振器長方向の両端面における幅W₁=2μm、リッジ部9の共振器長方向の中央部における幅W₂=4μmである。

【0046】上述のように構成されたこの発明の第1の実施形態によるGaN系半導体レーザによれば、リッジ部9が共振器長方向の両端部のそれぞれの領域に、共振器長方向の中央部から共振器長方向の両端部に向かう方向に幅が減少するテーパー領域9aを有することにより、次のような種々の利点を得ることができる。

【0047】すなわち、この第1の実施形態によるGaN系半導体レーザにおいては、リッジ部9が共振器長方向の両端部にテーパー領域9aを有することにより、リッジ部9の共振器長方向の両端面における幅W₁よりも、リッジ部9の共振器長方向の中央部における幅W₂の方が広くなる。そのため、横モードを安定に維持するために、リッジ部9の共振器長方向の両端面における幅W₁を3μm以下、具体的には例示したように2μmと狭く設定した場合であっても、それとは独立に、リッジ部9の共振器長方向の中央部における幅W₂を4μm以上、具体的には例示したように4μmと広く設定することができる。これにより、p型GaNコンタクト層8とp側電極11とのコンタクト面積を広くし、リッジ部9での抵抗成分を低減することができるので、このGaN系半導体レーザの駆動電圧を低減することができる。

【0048】このように、この第1の実施形態によれば、駆動電圧を上昇させることなく、横モードを安定に維持することができる。特に、共振器長L=500μm、テーパー領域9aの長さL₁=100μm、ストレート領域9bの長さL₂=300μm、リッジ部9の共振器長方向の両端面における幅W₁=2μm、リッジ部9の共振器長方向の中央部における幅W₂=4μmに設定されたこの第1の実施形態によるGaN系半導体レーザの場合、図4および図5に示す従来のGaN系半導体レーザにおいて、共振器長L=500μm、リッジ部109の幅W=3μmとした場合よりも電極コンタクト面積を広くとることができるので、横モードの安定化を図りつつ、駆動電圧を低減することができる。また、この第1の実施形態においては、リッジ部9の共振器長方向の両端面における幅W₁が2μmに設定されていることにより、キャリアのプラズマ効果を考慮に入れた基本モードの発振条件を満たすことが可能であり（図6参照）、したがって、高次の水平横モードの発生を抑制することができるので、横モードをより安定に維持することができる。

【0049】また、この第1の実施形態によれば、リッジ部9の共振器長方向の両端部のテーパー領域9aでの波面整形効果により、遼視野像の水平方向のビーム拡がり角θ//を広くすることができる。これに加えて、この第1の実施形態では、リッジ部9の共振器長方向の両端面における幅W₁が2μmと狭く設定されていることによって、遼視野像の水平方向のビーム拡がり角θ//がさ50倍以上に拡大されている。具体的には、リッジ部109の幅

W が $3\ \mu\text{m}$ の従来のGaN系半導体レーザでは、遠視野像の水平方向のビーム拡がり角 $\theta//$ が 6° であるのに対して、リッジ部9の共振器長方向の両端面における幅 W_1 が $2\ \mu\text{m}$ と狭窄化されたこの第1の実施形態によるGaN系半導体レーザでは、遠視野像の水平方向のビーム拡がり角 $\theta//$ を 8° 程度まで拡大することができる。これにより、このGaN系半導体レーザを光ディスク装置の光源に用いる場合、組み立て時に要求される厳しい位置精度を緩和することができる。また、この際、リッジ部9の共振器長方向の中央部における幅 W_2 を、リッジ部9の共振器長方向の両端面における幅 W_1 とは独立に広く設定することにより、電極コンタクト面積を減少させずに水平方向のビーム拡がり角 $\theta//$ の拡大を図ることができるために、信頼性良く遠視野像を整形することができる。

【0050】また、この第1の実施形態によれば、リッジ部9の共振器長方向の両端面における幅 W_1 が $2\ \mu\text{m}$ と狭く設定されていることにより、共振器端面の形状

(主にその傾き)による端面反射率の低下、閾値電流の上昇、スロープ効率の変化を抑制することができる。これにより、共振器端面の形状のバラツキによるレーザ特性の悪化を防止することができるので、特性の良好な半導体レーザを高い製造歩留まりで得ることができる。また、リッジ部9の共振器長方向の両端面における幅 W_1 が $2\ \mu\text{m}$ と狭く設定されていることにより、このGaN系半導体レーザが戻り光によって搅乱される度合いが抑制されるため、戻り光によって誘起されるノイズを低減することもできる。この際、この第1の実施形態においては、リッジ部9の共振器長方向の中央部における幅 W_2 を、リッジ部9の共振器長方向の両端面における幅 W_1 とは独立に広く設定することができるので、リッジ部9の共振器長方向の両端面における幅 W_1 を狭くすることにより得られるこれらの利点を、駆動電圧を上昇させることなく得ることができる。

【0051】以上のように、この第1の実施形態によれば、リッジ部9が、共振器長方向の両端部のそれぞれの領域に、共振器長方向の中央部から共振器長方向の両端部に向かう方向に幅が減少するテーパー領域9aを有することにより、リッジ部9の共振器長方向の両端面における幅 W_1 およびリッジ部の共振器長方向の中央部における幅 W_2 をそれぞれ最適化することができ、駆動電圧の低減、横モードの安定化、遠視野像の水平方向のビーム拡がり角 $\theta//$ の拡大、共振器端面の形状のバラツキによるレーザ特性の悪化防止およびノイズ特性の向上を容易に実現することができる。したがって、この第1の実施形態によれば、光ディスク装置の光源に適した、特性の良好なGaN系半導体レーザを得ることができる。

【0052】次に、この発明の第2の実施形態について説明する。図3は、この発明の第2の実施形態によるGaN系半導体レーザの平面図である。この第2の実施形

態によるGaN系半導体レーザでは、プロセス上のトランジットを考慮して、共振器長方向の両端面の近傍の所定の領域でリッジ部9の幅が一定にされる。なお、この第2の実施形態によるGaN系半導体レーザの接合と垂直な方向の構造は、第1の実施形態によるGaN系半導体レーザと同様に構成されている。

【0053】図3に示すように、この第2の実施形態によるGaN系半導体レーザにおけるリッジ部9は、共振器長方向の両端部のテーパー領域9aと両共振器端面との間のそれぞれの領域に、均一な幅 W_1 のストレート領域9cをさらに有する。図3において、 L_3 はこれらのストレート領域9cの長さを示す。ここで、これらのストレート領域9cは、リッジ部9の共振器長方向の両端面における幅を確実に W_1 とするために設けられるものであり、これらのストレート領域9cの長さ L_3 は極力短くすることが望ましい。この場合、これらのストレート領域9cの長さ L_3 の上限は、例えば $20\sim25\ \mu\text{m}$ 程度に選ばれる。

【0054】ここで、この第2の実施形態によるGaN系半導体レーザの各部の寸法の一例を挙げると、共振器長 $L=500\ \mu\text{m}$ 、リッジ部9のテーパー領域9aの長さ $L_1=100\ \mu\text{m}$ 、共振器長方向の中央部のストレート領域9bの長さ $L_2=250\ \mu\text{m}$ 、共振器長方向の両端部のストレート領域9cの長さ $L_3=25\ \mu\text{m}$ 、リッジ部9の共振器長方向の両端面における幅 $W_1=2\ \mu\text{m}$ 、リッジ部9の共振器長方向の中央部における幅 $W_2=4\ \mu\text{m}$ である。

【0055】この第2の実施形態によるGaN系半導体レーザの上記以外の構成は、第1の実施形態によるGaN系半導体レーザと同様であるので、説明を省略する。

【0056】この第2の実施形態によれば、第1の実施形態におけると同様の利点を得ることができると共に、次のような利点を合わせて得ることができる。すなわち、この第2の実施形態においては、リッジ部9の共振器長方向の両端部の領域に均一な幅 W_1 のストレート領域9cが設けられていることにより、共振器を加工する際に、リッジ部9の共振器長方向の両端面における幅を確実に W_1 とすることができます。これにより、共振器長方向の両端面におけるリッジ部9の幅が W_1 で、かつ、共振器長方向の中央部におけるリッジ部9の幅が W_2 であるようなテーパーストライプ型のリッジ構造を有するGaN系半導体レーザを高い製造歩留まりで得ることができる。

【0057】以上、この発明の実施形態について具体的に説明したが、この発明は、上述の実施形態に限定されるものではなく、この発明の技術的思想に基づく各種の変形が可能である。

【0058】例えば、上述の第1および第2の実施形態において挙げた数値、構造、材料などはあくまで例にすぎず、必要に応じてこれらと異なる数値、構造、材料な

どを用いてもよい。

【0059】具体的には、上述の第1および第2の実施形態における共振器長L、リッジ部9の共振器長方向の両端部のテーパー領域9aの長さL₁、リッジ部9の共振器長方向の中央部のストレート領域9bの長さL₂、リッジ部9の共振器長方向の両端部のストレート領域9cの長さL₃、リッジ部9の共振器長方向の両端面における幅W₁、リッジ部9の共振器長方向の中央部における幅W₂の値は、第1および第2の実施形態において挙げた諸条件を満たしていれば、任意に設定することができる。

【0060】また、上述の第1および第2の実施形態において、リッジ部9の共振器長方向の両端部のそれぞれの領域に設けられた2つのテーパー領域9aは、フロント側とリア側とで対称である必要はなく、さらに、リッジ部9の両側面も左右非対称であってもよい。また、リッジ部9のテーパー領域9aは、共振器長方向の中央部から共振器長方向の両端部に向かう方向に幅が単調に減少するのであれば、その側面が平面で構成されている必要はなく、例えば内側または外側に湾曲した曲面で構成されていてもよい。また、リッジ部9の共振器長方向の中央部のストレート領域9bの長さL₂を0として、リッジ部9を共振器長方向の両端部のテーパー領域9aのみ、または、テーパー領域9aおよびストレート領域9cのみとしてもよい。

【0061】また、上述の第1および第2の実施形態においては、リッジ部9の両側に埋め込まれる電流狭窄層の材料としてSiO₂が用いられているが、この電流狭窄層の材料としては、これ以外にもAlGaN、GaN、GaNなどの窒化物系II-V族化合物半導体、SiNなどの誘電体、ZnSなどのII-VI族化合物半導体を用いてもよい。

【0062】また、上述の第1および第2の実施形態において、レーザ構造を形成する各半導体層の導電型を対にしてよい。

【0063】また、上述の第1および第2の実施形態においては、基板としてサファイア基板を用いているが、これは、サファイア基板に代えてスピネル基板、SiC基板、ZnO基板、GaN基板などを用いてもよいし、あるいは、これらの基板上に窒化物系II-V族化合物半導体層が成長された基板、これらの基板上に窒化物系II-V族化合物半導体層を成長させた後、基板を研磨等で取り去り窒化物系II-V族化合物半導体層のみを持つ基板、GaN基板のような窒化物系II-V族化合物半導体そのものからなる基板などを用いてよい。

【0064】また、上述の第1および第2の実施形態においては、この発明をDH構造(Double Heterostructu

re)のGaN系半導体レーザに適用した場合について説明したが、この発明はSCH構造(Separate Confinement Heterostructure)のGaN系半導体レーザに適用することも可能である。

【0065】

【発明の効果】上述のように構成されたこの発明によれば、リッジ部が、共振器長方向の両端部に共振器長方向の中央部から共振器長方向の両端部に向かう方向に幅が減少するテーパー領域を有することにより、リッジ部の共振器長方向の中央部における幅およびリッジ部の共振器長方向の両端面における幅をそれぞれ最適化することができる、駆動電圧の低減、横モードの安定化、遠視野像の水平方向のビーム拡がり角の拡大、共振器端面の形状のバラツキによるレーザ特性の悪化防止およびノイズ特性の向上を容易に実現することができる。これにより、光ディスク装置の光源に適した、特性の良好な窒化物系II-V族化合物半導体を用いた半導体レーザを得ることができる。

【図面の簡単な説明】

【図1】この発明の第1の実施形態によるGaN系半導体レーザの斜視図である。

【図2】この発明の第1の実施形態によるGaN系半導体レーザの平面図である。

【図3】この発明の第2の実施形態によるGaN系半導体レーザの平面図である。

【図4】従来のGaN系半導体レーザの斜視図である。

【図5】従来のGaN系半導体レーザの平面図である。

【図6】GaN系半導体レーザにおける基本モードの発振条件を示すグラフである。

【図7】GaN系半導体レーザにおける共振器端面の傾きとレーザ光の出射方向との関係を示すグラフである。

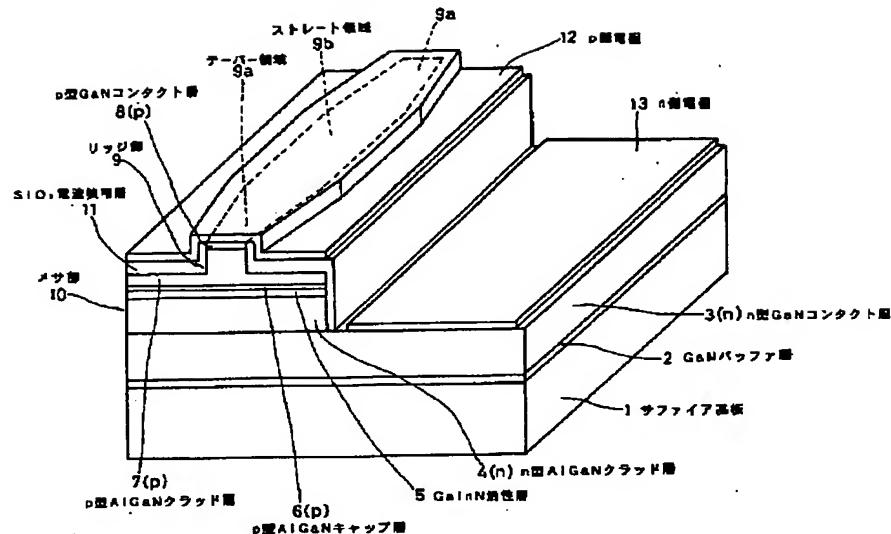
【図8】GaN系半導体レーザにおける共振器端面の傾きと端面反射率との関係を示すグラフである。

【図9】GaN系半導体レーザにおける共振器端面の傾きと閾値電流の上昇分との関係を示すグラフである。

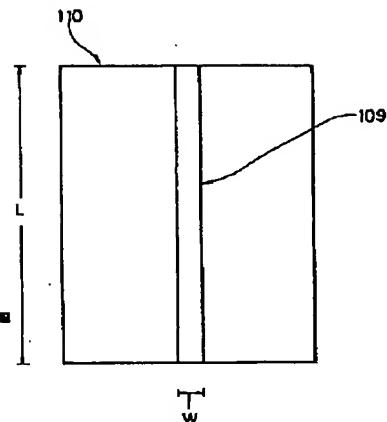
【符号の説明】

1 . . . サファイア基板、2 . . . GaNバッファ層、3 . . . n型GaNコンタクト層、4 . . . n型AlGaNクラッド層、5 . . . GaInN活性層、6 . . . p型AlGaNキャップ層、7 . . . p型AlGaNクラッド層、8 . . . p型GaNコンタクト層、9 . . . リッジ部、9a . . . テーパー領域、9b、9c . . . ストレート領域、10 . . . SiO₂電流狭窄層、11 . . . p側電極、12 . . . n側電極

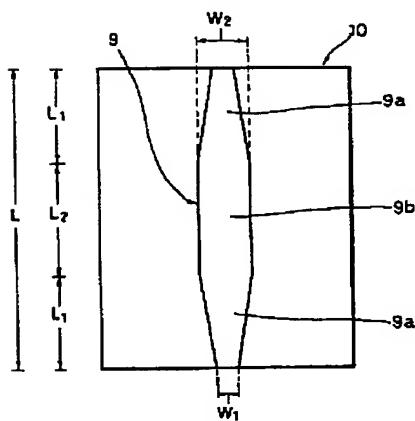
【図1】



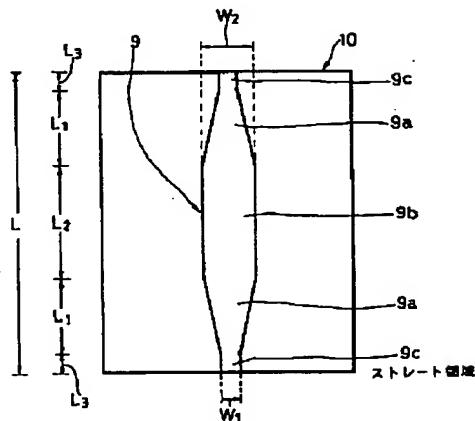
【図5】



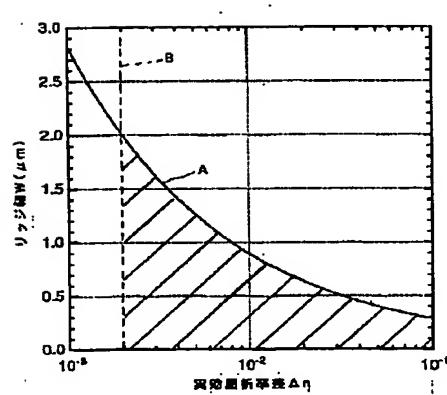
【図2】



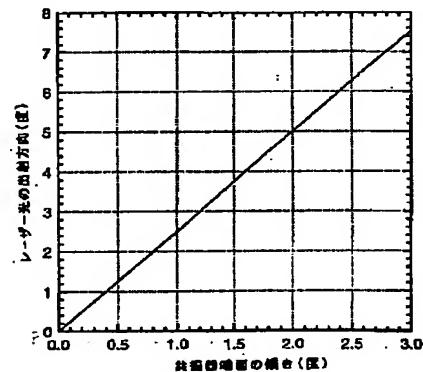
【図3】



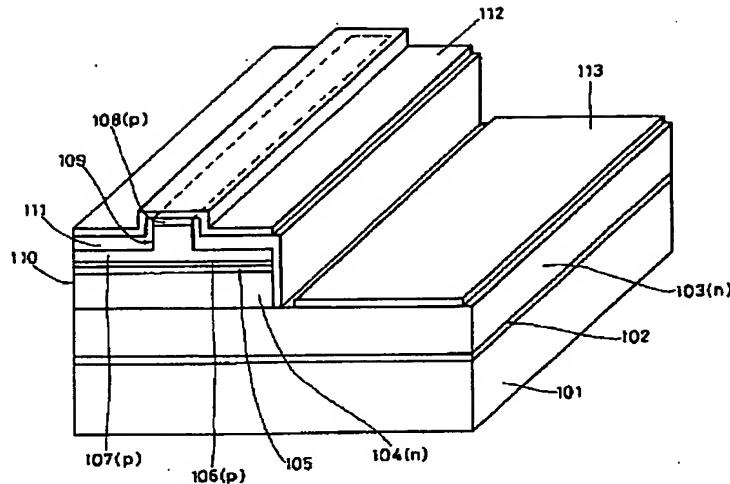
【図6】



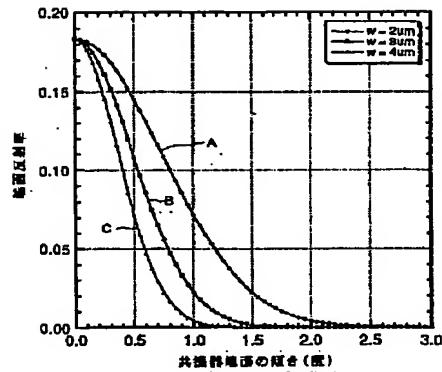
【図7】



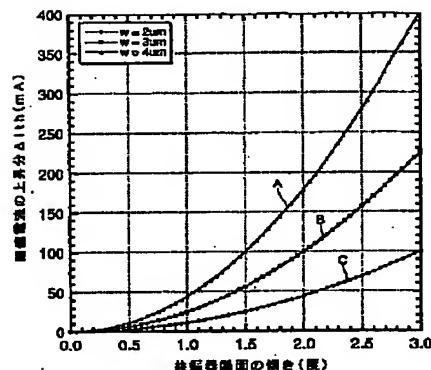
【図4】



【図8】



【図9】



フロントページの続き

(72)発明者 内田 史朗
東京都品川区北品川6丁目7番35号 ソニ
一株式会社内

(72)発明者 平田 照二
東京都品川区北品川6丁目7番35号 ソニ
一株式会社内
F ターム(参考) 5F041 AA06 CA04 CA34 CA40 CA46
5F073 AA13 AA35 BA06 CA07 CB05
EA19 EA27